

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分  
 【発行日】平成 26 年 7 月 24 日 (2014.7.24)

【公開番号】特開 2013-157458 (P2013-157458A)  
 【公開日】平成 25 年 8 月 15 日 (2013.8.15)  
 【年通号数】公開・登録公報 2013-043  
 【出願番号】特願 2012-16819 (P2012-16819)  
 【国際特許分類】

H 0 1 L 31/042 (2014.01)

【 F I 】

H 0 1 L 31/04 R

【手続補正書】  
 【提出日】平成 26 年 6 月 5 日 (2014.6.5)  
 【手続補正 1】  
 【補正対象書類名】明細書  
 【補正対象項目名】0 0 4 7  
 【補正方法】変更  
 【補正の内容】  
 【 0 0 4 7 】

そこで、下式 ( 2 ) に示すように、バイパスダイオード 3 0 を太陽電池クラスタ 2 0 に並列に接続し、太陽電池クラスタ 2 0 の電圧損失  $V_{loss}$  を抑制することで、低日射太陽電池セル 2 1 b の電圧損失  $V_{cell}$  が電圧ゲイン  $V_g$  を大きく超えるのを回避することができる。

$$V_{cell} = V_{loss} + V_g \quad \dots (2)$$

$V_{cell}$  : 低日射太陽電池セル 2 1 b の電圧損失

$V_{loss}$  : 太陽電池クラスタ 2 0 の電圧損失

$V_g$  : 太陽電池クラスタ 2 0 の 高日射太陽電池セル 2 1 a の電圧ゲインの合計